

InP-Kurzkanal- Heterostruktur-Feldeffekttransistoren mit elektronenstrahldefinierten Gate-Kontakten

Vom Fachbereich Elektrotechnik der
Gerhard-Mercator-Universität - Gesamthochschule Duisburg

zur Erlangung des akademischen Grades eines

Doktor-Ingenieurs

genehmigte Dissertation

von Diplom-Ingenieur

WALTER DAUMANN

aus

Dinslaken

Referent: Prof. Dr. rer. nat. F.J. Tegude
Korreferent: Prof. Dr. rer. nat. K. Heime

Tag der mündlichen Prüfung: 26. Juni 2000